

calculatoratoz.comunitsconverters.com

Características del circuito CMOS Fórmulas

[¡Calculadoras!](#)[¡Ejemplos!](#)[¡Conversiones!](#)

Marcador calculatoratoz.com, unitsconverters.com

Cobertura más amplia de calculadoras y creciente - **¡30.000+ calculadoras!**

Calcular con una unidad diferente para cada variable - **¡Conversión de unidades integrada!**

La colección más amplia de medidas y unidades - **¡250+ Medidas!**

¡Siéntete libre de COMPARTIR este documento con tus amigos!

[Por favor, deje sus comentarios aquí...](#)



Lista de 15 Características del circuito CMOS Fórmulas

Características del circuito CMOS ↗

1) Ancho de difusión de la fuente ↗

fx
$$W = \frac{A_s}{D_s}$$

Calculadora abierta ↗

ex
$$89.81967\text{mm} = \frac{5479\text{mm}^2}{61\text{mm}}$$

2) Ancho de la puerta ↗

fx
$$W_g = \frac{C_{in}}{C_{ox} \cdot L_g}$$

Calculadora abierta ↗

ex
$$0.285667\text{mm} = \frac{60.01\mu\text{F}}{30.01\mu\text{F}/\text{mm}^2 \cdot 7\text{mm}}$$

3) Ancho de la región de agotamiento ↗

fx
$$L_d = L_{pn} - L_{eff}$$

Calculadora abierta ↗

ex
$$11\text{mm} = 19\text{mm} - 8\text{mm}$$



4) Ancho de transición de CMOS ↗

fx $W = \frac{C_{\text{mos}}}{C_{\text{gs}}}$

Calculadora abierta ↗

ex $89.82036\text{mm} = \frac{1.8\mu\text{F}}{20.04\mu\text{F}}$

5) Área de difusión de fuentes ↗

fx $A_s = D_s \cdot W$

Calculadora abierta ↗

ex $5479.02\text{mm}^2 = 61\text{mm} \cdot 89.82\text{mm}$

6) Campo eléctrico crítico ↗

fx $E_c = \frac{2 \cdot V_{\text{sat}}}{\mu_e}$

Calculadora abierta ↗

ex $0.004064\text{V/mm} = \frac{2 \cdot 10.12\text{mm/s}}{49.8\text{cm}^2/\text{V*s}}$

7) Capacitancia efectiva en CMOS ↗

fx $C_{\text{eff}} = D \cdot \frac{i_{\text{off}} \cdot (10^{V_{\text{bc}}})}{N_g \cdot [\text{BoltZ}] \cdot V_{\text{bc}}}$

Calculadora abierta ↗

ex $5.137895\mu\text{F} = 1.3E^{-25} \cdot \frac{0.01\text{mA} \cdot (10^{2.02\text{V}})}{0.95 \cdot [\text{BoltZ}] \cdot 2.02\text{V}}$



8) CMOS significa ruta libre ↗

fx $L = \frac{V_c}{E_c}$

Calculadora abierta ↗

ex $697.5\text{mm} = \frac{2.79\text{V}}{0.004\text{V/mm}}$

9) Espesor de la capa de óxido ↗

fx $t_{ox} = \epsilon_{ox} \cdot W_g \cdot \frac{L_g}{C_{in}}$

Calculadora abierta ↗

ex $4.979688\text{mm} = 149.79\mu\text{F/mm} \cdot 0.285\text{mm} \cdot \frac{7\text{mm}}{60.01\mu\text{F}}$

10) Longitud de unión PN ↗

fx $L_{pn} = L_d + L_{eff}$

Calculadora abierta ↗

ex $19.01\text{mm} = 11.01\text{mm} + 8\text{mm}$

11) Longitud efectiva del canal ↗

fx $L_{eff} = L_{pn} - L_d$

Calculadora abierta ↗

ex $7.99\text{mm} = 19\text{mm} - 11.01\text{mm}$



12) Perímetro de la pared lateral de la fuente de difusión 

fx $P_s = (2 \cdot W) + (2 \cdot D_s)$

Calculadora abierta 

ex $301.64\text{mm} = (2 \cdot 89.82\text{mm}) + (2 \cdot 61\text{mm})$

13) Permitividad de la capa de óxido 

fx $\epsilon_{ox} = t_{ox} \cdot \frac{C_{in}}{W_g \cdot L_g}$

Calculadora abierta 

ex $149.7994\mu\text{F}/\text{mm} = 4.98\text{mm} \cdot \frac{60.01\mu\text{F}}{0.285\text{mm} \cdot 7\text{mm}}$

14) Voltaje crítico CMOS 

fx $V_c = E_c \cdot L$

Calculadora abierta 

ex $2.79028\text{V} = 0.004\text{V}/\text{mm} \cdot 697.57\text{mm}$

15) Voltaje en EDP Mínimo 

fx $V_{edp} = \frac{3 \cdot V_t}{3 - \alpha}$

Calculadora abierta 

ex $0.666667\text{V} = \frac{3 \cdot 0.3\text{V}}{3 - 1.65}$



Variables utilizadas

- μ_e Movilidad del electrón (*centímetro cuadrado por segundo voltio*)
- A_s Área de difusión de fuentes (*Milímetro cuadrado*)
- C_{eff} Capacitancia efectiva en CMOS (*Microfaradio*)
- C_{gs} Capacitancia de puerta MOS (*Microfaradio*)
- C_{in} Capacitancia de la puerta de entrada (*Microfaradio*)
- C_{mos} Capacitancia de superposición de puerta MOS (*Microfaradio*)
- C_{ox} Capacitancia de la capa de óxido de puerta (*Microfaradio por milímetro cuadrado*)
- D Ciclo de trabajo
- D_s Longitud de la fuente (*Milímetro*)
- E_c Campo eléctrico crítico (*voltios por milímetro*)
- i_{off} Apagado actual (*Miliamperio*)
- L Camino libre medio (*Milímetro*)
- L_d Ancho de la región de agotamiento (*Milímetro*)
- L_{eff} Longitud efectiva del canal (*Milímetro*)
- L_g Longitud de la puerta (*Milímetro*)
- L_{pn} Longitud de unión PN (*Milímetro*)
- N_g Puertas en el camino crítico
- P_s Perímetro de difusión de la fuente en la pared lateral (*Milímetro*)
- t_{ox} Espesor de la capa de óxido (*Milímetro*)
- V_{bc} Voltaje base del colector (*Voltio*)



- V_c Voltaje crítico en CMOS (Voltio)
- V_{edp} Tensión al mínimo EDP (Voltio)
- V_{sat} Saturación de velocidad (Milímetro/Segundo)
- V_t Voltaje umbral (Voltio)
- W Ancho de transición (Milímetro)
- W_g Ancho de la puerta (Milímetro)
- α Factor de actividad
- ϵ_{ox} Permitividad de la capa de óxido (Microfaradio por milímetro)



Constantes, funciones, medidas utilizadas

- **Constante:** [BoltZ], 1.38064852E-23 Joule/Kelvin
Boltzmann constant
- **Medición:** Longitud in Milímetro (mm)
Longitud Conversión de unidades ↗
- **Medición:** Corriente eléctrica in Miliamperio (mA)
Corriente eléctrica Conversión de unidades ↗
- **Medición:** Área in Milímetro cuadrado (mm²)
Área Conversión de unidades ↗
- **Medición:** Velocidad in Milímetro/Segundo (mm/s)
Velocidad Conversión de unidades ↗
- **Medición:** Capacidad in Microfaradio (μ F)
Capacidad Conversión de unidades ↗
- **Medición:** Fuerza de campo eléctrico in voltios por milímetro (V/mm)
Fuerza de campo eléctrico Conversión de unidades ↗
- **Medición:** Potencial eléctrico in Voltio (V)
Potencial eléctrico Conversión de unidades ↗
- **Medición:** Movilidad in centímetro cuadrado por segundo voltio (cm²/V*s)
Movilidad Conversión de unidades ↗
- **Medición:** Capacitancia de óxido por unidad de área in Microfaradio por milímetro cuadrado (μ F/mm²)
Capacitancia de óxido por unidad de área Conversión de unidades ↗
- **Medición:** Permitividad in Microfaradio por milímetro (μ F/mm)
Permitividad Conversión de unidades ↗



Consulte otras listas de fórmulas

- Subsistema de ruta de datos de matriz Fórmulas 
- Características del circuito CMOS Fórmulas 
- Características de retardo CMOS Fórmulas 
- Características de diseño CMOS Fórmulas 
- Métricas de potencia CMOS Fórmulas 
- Subsistema de propósito especial CMOS Fórmulas 
- Características de tiempo CMOS Fórmulas 

¡Síntete libre de COMPARTIR este documento con tus amigos!

PDF Disponible en

[English](#) [Spanish](#) [French](#) [German](#) [Russian](#) [Italian](#) [Portuguese](#) [Polish](#) [Dutch](#)

10/31/2023 | 8:28:52 PM UTC

[Por favor, deje sus comentarios aquí...](#)

